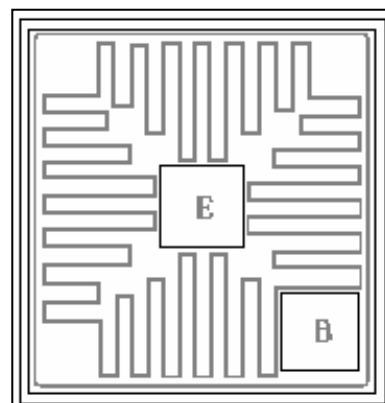




芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
 芯片代码：A089BJ-01
 芯片厚度：240 ± 20μm
 管芯尺寸：890 × 890μm²
 焊位尺寸：B 极 150×150μm²；E 极 153×153μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：KSA928A，H928S

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温.....150
 P_C——集电极耗散功率.....0.75W
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....-30V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-30V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V
 I_C——集电极电流..... -2A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-30			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-30			V	I _C =-10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-1mA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	nA	V _{CB} =-30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V _{EB} =-5V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	100		320		V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-2	V	I _C =-1.5A, I _B =-30mA
V _{BE(on)}	基极—发射极导通电压			-1	V	V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
f _T	特征频率		120		MHz	V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
C _{ob}	共基极输出电容		30		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz